

# 2SB807

## シリコン PNP エピタキシャルプレーナ形 / Si PNP Epitaxial Planar

高耐圧低雑音増幅用 / High Voltage Low-noise Amplifier  
2SD1009とコンプリメンタリ / Complementary Pair with 2SD1009

### ■ 特徴 / Features

- コレクタ・エミッタ電圧  $V_{CEO}$  が高い。 / High  $V_{CEO}$
- コレクタ損失  $P_C$  が大きい。 / Large  $P_C$
- ミニ型パワーパッケージのため機器の小型化および、マガジン包装による自動挿入が可能。

MINI Type Power package suitable for small equipment and magazine types for automatic insertion are available.

### ■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$	-150	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	-150	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	-5	V
せん頭コレクタ電流	$I_{CP}$	-100	mA
コレクタ電流	$I_C$	-50	mA
コレクタ損失	$P_C^*$	1	W
接合部温度	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

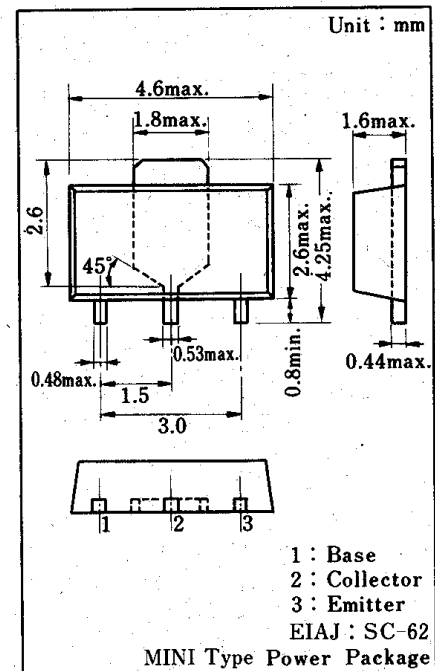
\*プリント基板：コレクタ部分の銅箔面積  $1\text{cm}^2$  以上、厚み  $1.7\text{mm}$   
Copper plate at the collector is more than  $1\text{cm}^2$  in area,  $1.7\text{mm}$  in thickness.

### ■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしゃ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = -100\text{V}, I_E = 0$			-1	$\mu\text{A}$
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	$I_C = -100\mu\text{A}, I_B = 0$	-150			V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	$I_E = -10\mu\text{A}, I_C = 0$	-5			V
直流電流増幅率	$h_{FE}^*$	$V_{CE} = -10\text{V}, I_C = -10\text{mA}$	90		450	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -30\text{mA}, I_B = -3\text{mA}$			-1	V
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CB} = -10\text{V}, I_E = 10\text{mA}$		200		MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB} = -10\text{V}, I_E = 0, f = 1\text{MHz}$			5	pF
雑音電圧	NV	$V_{CE} = -10\text{V}, I_C = -1\text{mA}, G_v = 80\text{dB}$ $R_g = 100\text{k}\Omega, \text{Function} = \text{FLAT}$		150		mV

\*  $h_{FE}$  ランク分類 /  $h_{FE}$  Classifications

Class	Q	R	S	T
$h_{FE}$	90~155	130~220	185~330	260~450
Marking Symbol	FQ	FR	FS	FT



### ■ 形名表示記号(例) Marking Symbol

Type No.  $h_{FE}$  Classification

